

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)

【公開番号】特開2018-10929(P2018-10929A)

【公開日】平成30年1月18日(2018.1.18)

【年通号数】公開・登録公報2018-002

【出願番号】特願2016-137730(P2016-137730)

【国際特許分類】

H 01 L 25/07 (2006.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

H 01 L 23/36 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/04 C

H 01 L 23/36 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年11月19日(2018.11.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

第1金属パターン12bには第1金属接合材16、20で半導体チップ18、22が固定されている。半導体チップ18、22はSiCによって形成されている。半導体チップ18は例えばIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)であり、半導体チップ22は例えば還流ダイオードである。SiCによって形成された半導体チップ又はウエハの厚みは0.25mm～0.35mmとすることが一般的である。例えば、特開2014-82361号公報の明細書段落0005にはn型SiCウエハの厚さが350μmであることが開示されている。本発明の実施の形態1に係る半導体モジュールの半導体チップ18、22の厚みZ2は0.25mm以上0.35mm以下とした。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図4】

